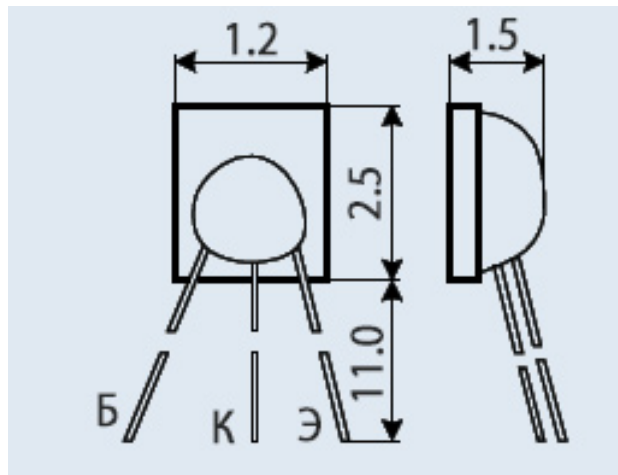


## Транзистор 2Т629АМ-2



Транзисторы 2Т629АМ-2 кремниевые эпитаксиально-планарные структуры р-п-р переключаательные. Предназначены для применения в быстродействующих импульсных устройствах в составе гибридных интегральных микросхем.

Бескорпусные, на кристаллодержателе с защитным покрытием с гибкими выводами.

Транзисторы 2Т629А-5 выпускается в виде неразделенных кристаллов на пластине с контактными площадками для гибридных интегральных микросхем.

Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,02 г.

Категория качества: «ВП».

Технические условия:

- приемка «5» - ЩЫ0.336.032ТУ.

Зарубежный аналог: 2N3245, 2N3671.

Гарантийный срок хранения 25 лет со дня изготовления.

### Гарантийная наработка:

- 50000 ч - в режимах и условиях, допускаемых ТУ;
- 80000 ч - в облегченном режиме.

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока хранения.

### Основные технические характеристики транзистора 2Т629АМ-2:

- Структура транзистора: р-п-р;
- $P_{к\max}$  - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 1 Вт;
- $f_{гр}$  - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 250 МГц;
- $U_{кбо\max}$  - Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 50 В;
- $U_{эбо\max}$  - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4,5 В;
- $I_{к\max}$  - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 1000 мА;

- $I_{кб0}$  - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 5 мкА (50В);
- $h_{21Э}$  - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 25... 80;
- $C_k$  - Емкость коллекторного перехода: не более 25 пФ;
- $R_{кэ нас}$  - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 2 Ом;
- $\tau_k$  - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 90 пс

### Характеристики транзисторов 2Т629А-2, 2Т629А-2Н, 2Т629АМ-2, 2Т629АМ-2Н, 2Т629А-5

Тип транзистора	Структура	Предельные значения параметров при $T_p=25^\circ\text{C}$						Значения параметров при $T_p=25^\circ\text{C}$								$T_{П max}$	$T_{max}$
		$I_{К max}$	$I_{К. И. max}$	$U_{КЭR max}$ ( $U_{КЭ0 max}$ )	$U_{КБ0 max}$	$U_{ЭБ0 max}$	$P_{К max}$ ( $P_{К. Т. max}$ )	$h_{21Э}$	$U_{КЭ нас.}$	$I_{КБ0}$	$I_{ЭБ0}$	$I_{КЭR}$	$f_{гр.}$	$C_k$	$C_{Э}$		
		А	А	В	В	В	Вт		В	мкА	мкА	мкА	МГц	пФ	пФ		
2Т629А-2	р-п-р	1	-	50	50	4,5	0,18 (1)	25...80	-	<5	<5	-	>250	<20	-	135	- 60...+125
2Т629А-2Н	р-п-р	1	-	50	50	4,5	0,18 (1)	25...80	-	<5	<5	-	>250	<20	-	135	- 60...+125
2Т629АМ-2	р-п-р	1	-	50	50	4,5	0,18 (1)	25...80	-	<5	<5	-	>250	<20	-	135	- 60...+125
2Т629АМ-2Н	р-п-р	1	-	50	50	4,5	0,18 (1)	25...80	-	<5	<5	-	>250	<20	-	135	- 60...+125
2Т629А-5	р-п-р	1	-	50	50	4,5	0,18 (1)	25...80	-	<5	<5	-	>250	<20	-	135	- 60...+125

### Условные обозначения электрических параметров транзисторов:

- $I_{К max}$  - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
- $I_{К. И. max}$  - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
- $U_{КЭR max}$  - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
- $U_{КЭ0 max}$  - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю.
- $U_{КБ0 max}$  - максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю.
- $U_{ЭБ0 max}$  - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
- $P_{К max}$  - максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора.
- $P_{К. Т. max}$  - максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора с теплоотводом.
- $h_{21Э}$  - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.

- $U_{КЭ\text{ нас.}}$  - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
- $I_{КБО}$ - обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
- $I_{ЭБО}$ - обратный ток эмиттера. Ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер-база и разомкнутом выводе коллектора.
- $I_{КЭР}$  - обратный ток коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база- эмиттер.
- $f_{гр}$  - граничная частота коэффициента передачи тока.
- $C_K$  - емкость коллекторного перехода.
- $C_E$  - емкость эмиттерного перехода.
- $T_{П\text{ max}}$  - максимально допустимая температура перехода.
- $T_{\text{ max}}$  - максимально допустимая температура окружающей среды.